

<b>Unidade</b> <b>PÓS-GRADUAÇÃO ENGENHARIA</b> <b>ELÉTRICA</b>	<b>Área</b> <b>NANOELETRÔNICA E CIRCUITOS INTEGRADOS</b>
<b>Disciplina</b> PEL104 – Caracterização Elétrica de Dispositivos MOS	<b>Tipo</b> Optativa
<b>Carga Horária</b> 4 horas semanais em 12 semanas	
<b>Objetivos</b> Apresentar as principais estruturas de caracterização elétrica e métodos de medidas das principais características elétricas dos transistores MOS.	
<b>Metodologia Adotada</b> Abordagem expositiva em sala de aula e uso de laboratório.	
<b>Recursos necessários</b> Sala de Aula e Laboratório de Caracterização de Dispositivos Eletrônicos.	
<b>Programa para 12 semanas</b> 1. Capacitores MOS; 2. Capacitores MOS; 3. Capacitores MOS; 4. Capacitores MOS – Experimental; 5. Funcionamento dos transistores MOS; 6. Funcionamento dos transistores MOS; 7. Principais características elétricas dos transistores MOS; 8. Transistores MOS – Experimental; 9. Diodos; 10. Diodos – Experimental; 11. Estruturas para caracterização de processos; 12. Estruturas para caracterização de processos – Experimental.	
<b>Método de Avaliação</b> Provas e Trabalho Final.	
<b>Bibliografia Básica</b> - J. A. Martino, M. A. Pavanello e P. B. Verdonck, Caracterização Elétrica de Tecnologia e Dispositivos MOS, Editora Thomson Learning, 2003.	

Atualizada: 07/2011